

■ 第6回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演

講演題目: 面発光レーザー –並列フォトニクスの芽–
受賞者: 伊賀 健一(日本学術振興会、理事)
日時: 2006年3月22日(水) 13:15 ~ 14:05
会場: ZN(3号館 3F-312)

伊賀健一氏は、1979年にGaInAsP系で初めて電流注入での面発光レーザー発振を実現した。さらに、共振器の長さが10 μm 以下という極短共振器構造を提唱し、通常の半導体レーザーと比べて極めて小さな電流で動作するマイクロ構造レーザーの有効性を実証した。その後、同氏の東工大研究チームは室温で連続的に動作するデバイスを実現して、実用化への道を切り拓くとともに、多くの基本デバイスコンセプトを提示してきた。

このような面発光レーザーの基礎技術開拓からデバイス実現にいたる先導研究は、世界的に新たな研究分野を創出し、日本発の成果を世界に示した。多くの研究機関で研究開発と実用化が進められ、産業的な発展にまで大きく貢献しており、このため同氏は面発光レーザーの研究者として世界的に広く認知されている。

面発光レーザーは、近年ギガビットイーサなど超高速データ通信用光源として、不可欠のデバイスとなった。面発光レーザーの低消費電力特性と高密度集積性を活かした超高速光インターコネクト技術は、ストレージなどの大規模集積システムの配線ボトルネックを打破する。また、レーザープリンター、センサーなどの並列フォトニクスの多様な展開も進んでいる。

同氏の著書、論文、講演、講義を通じた面発光レーザーに関する分野形成は、微小共振器による自然放出制御、フォトニック結晶などの新分野研究を誘発し、学術的にも大きな影響を与えている。なお、面発光レーザーに関する最初の発表は1978年春の応用物理学関係連合講演会である。

講演題目: マイクロビームアナリシス –その基礎的研究から国際標準化へ–
受賞者: 志水 隆一(大阪工業大学、教授)
日時: 2006年3月23日(木) 9:00 ~ 9:50
会場: ZL(5号館 B1F小講堂)

マイクロビームアナリシスは、電子やイオンに代表される荷電粒子やX線などの放射線をプローブとして試料の微小領域のキャラクタリゼーションを行うものである。したがって、プローブと固体との相互作用についての定量的な知見を必要とする。電子線、イオンビーム、X線が固体内に入射し、種々の散乱過程を経ながら、どのように信号(例えば電子線励起X線、スパッタリング、光電子)を生成し、検出されるに到るのか。それら各プロセスが正確に理解されてはじめて、マイクロビームアナリシスの実用化が実現する。モンテカルロシミュレーションはこのような要請に応える最も有用な計算手法であり、とくにマイクロビームアナリシスの分野で目覚ましい発展を遂げたことは周知の通りである。筆者は幸いにしてこのようなモンテカルロシミュレーションの創成時に会うことが出来た。

ここでは、筆者が従事した荷電粒子と固体との相互作用に関するモンテカルロシミュレーションの発展をたどり、それらが後述する国際標準化活動にどのように引き継がれていったかを述べる。

我が国のマイクロビームアナリシスの国際標準化活動への参加は1985年である。日本学術振興会第141(マイクロビームアナリシス)委員会が要請に応じてその任にあたったのである。これが発展して、1992年に発足したISO-TC201(表面化学分析)の幹事国となり、以来2名の国際議長を日本から出してマイクロビームアナリシスの分野における国際標準化の牽引車となっている。

このような労多くして報われることの少ない国際標準化活動を支えた関係者各位への思いを新たにしていただけるならば筆者としても望外の幸せである。

■第19回(2005年秋季)応用物理学会講演奨励賞 賞状・記念品の贈呈式

標記贈呈式を下記により公開で行います。ふるってご参加ください。

日時： 3月22日(水) 12:00～13:00

会場： 武蔵工業大学 世田谷キャンパス 3号館4Fメモリアルホール(ZQ会場)

〈受賞者一覧〉

講演奨励賞受賞者 (講演時の所属)	講演題目 (受賞者以外の共著者の所属：共著者)	講演奨励賞受賞者 (講演時の所属)	講演題目 (受賞者以外の共著者の所属：共著者)
野尻 康弘 (名大工)	シート状長尺プラズマの生成・診断 (名大工：石島 達夫, 菅井 秀郎)	三崎 雅裕 (神戸大院, 産総研光技術)	ポリフルオレン摩擦転写膜を用いた青色偏光LEDの作製 (神戸大院 ¹ , 産総研光技術 ² , 九大工 ³ :永松 秀一 ^{2,3} , 近松 真之 ² , 吉田 郵司 ² , 谷垣 宣孝 ² , 八瀬 清志 ² , 上田 裕清 ¹)
加納 英明 (東大院理)	超広帯域マルチプレックスCARS顕微鏡による分子振動 イメージング ～分子J会合体から単一生細胞まで～ (東大院理：濱口 宏夫)	星野 雄亮 (東工大大院理工)	円偏光照射によるアキラルなアゾダイマー系のキラリ ティー制御 (東工大大院理工：Sun-Won Choi, 泉 達矢, 高西 陽一, 石川 謙, 渡辺 順次, 竹添 秀男)
若山 俊隆 (農工大院)	分光偏光変調による直線・円偏屈折分散計測 (農工大院：大谷 幸利, 梅田 倫弘)	伊藤 健 (神奈川産総研)	感光性シートを用いたマイクロ流体デバイスの開発 (神奈川産総研 ¹ , 日立化成工業 ² , 慶大理工 ³ , CREST-JST ⁴ : 川口 卓 ² , 三好 裕子 ² , 丸山 健一 ³ , 本田 亜希 ⁴ , 大屋 誠志郎 ¹ , 鈴木 孝治 ^{3,4})
奈良崎 愛子 (産総研)	KrFエキシマレーザー照射によるガラス表面への光触媒能を 有するTiO ₂ 網目構造の形成 (産総研 ¹ , 日本板硝子 ² :川口 喜三 ¹ , 新納 弘之 ¹ , 小路谷 将範 ² , 小用 広隆 ² , 常友 啓司 ²)	入沢 寿史 (MIRAI-ASET)	横方向歪み緩和を用いて試作した高駆動力一軸歪みSGOI pMOSFETs (MIRAI-ASET ¹ , MIRAI-AIST ² , 東芝セラミックス ³ , 東大新領域 ⁴ :沼田 敏典 ² , 手塚 勉 ¹ , 白田 宏治 ¹ , 平下 紀夫 ¹ , 杉山 直治 ¹ , 豊田 英二 ³ , 高木 信一 ^{2,4})
高柳 順 (名大院工)	高強度ラマンソリトンと高非線形ファイバを用いた超広帯 域フラットスペクトル光の生成 (名大院工：西澤 典彦)	筒井 元 (東大生研)	面方位(110)極薄SOI pMOSFETにおける高移動度の実証 (東大生研：齋藤 真澄, 平本 俊郎)
尾島 靖國 (千葉大工)	マルチパス増幅器を用いた>10W高品位ピコ秒位相共役 Nd:YVO ₄ レーザーシステム (千葉大工：縄田 耕二, 後藤 正人, 尾松 孝茂)	清家 綾 (早大理工)	Siナノ細線における不純物イオンの挙動評価(2) (早大理工 ¹ , 早大材研 ² :沼尾 吉照 ¹ , 佐野 一拓 ¹ , 大泊 巖 ^{1,2})
浦田 涼平 (NTTフォトニクス研)	光クロックトランジスタレイを用いた高速光シリアル 電気パラレル双方向変換器 (NTTフォトニクス研：高橋 亮, 中原 達志, 高畑 清人, 鈴木 博之)	早瀬(伊師) 潤子 (情通機構)	通信波長帯超高密度量子ドットのフォトンエコー法による 位相緩和測定(情通機構 ¹ , 上智大理工 ² :赤羽 浩一 ¹ , 山本 直克 ¹ , 鯨岡 真美子 ^{1,2} , 江馬 一弘 ² , 佐々木 雅英 ¹)
橋爪 滋郎 (東工大精研)	ナノ構造を用いた面発光レーザーの偏光モード制御の検討 (東工大精研：小山 二三夫)	野瀬 嘉太郎 (東北大金研)	新成長法「核形成制御キャスト成長法」による太陽電池用 Siバルク結晶の成長 (東北大金研：高橋 勲, 藩 伍根, 藤原 航三, 宇佐美 徳隆, 中嶋 一雄)
新井 涼太 (阪府大工)	ZnO/YMnO ₃ ヘテロ構造を用いた強誘電体ゲート圧電半導 体薄膜トランジスタの作製と評価 (阪府大工：重光 学道, 益子 慶一郎, 吉村 武, 芦田 淳, 藤村 紀文)	山本 直克 (情通機構)	アンチモン系量子ドットの作製とその光通信波長1.55 μm 帯面発光レーザー応用 (情通機構 ¹ , 同志社大 ² :赤羽 浩一 ¹ , 牛頭 信一郎 ¹ , 上田 章雄 ¹ , 大谷 直毅 ²)
手塚 真一郎 (早大理工)	高濃度ボロンドープCVDダイヤモンド超伝導体における Jc評価構造の検討 (早大理工 ¹ , 物質・材料研究機構 ² :石綿 整 ¹ , 竹之内 智大 ¹ , 高野 義彦 ² , 長尾 雅則 ² , 坂口 勲 ² , 立木 実 ² , 波多野 毅 ² , 川原田 洋 ¹)	熊谷 裕也 (立命館大院理工)	ECR-MBE法によるR面サファイア基板上A面InNの成長 (立命館大院理工 ¹ , COE推進機構 ² :露口 招弘 ¹ , 寺木 邦子 ¹ , 荒木 努 ¹ , 直井 弘之 ² , 名西 徳之 ¹)
鈴木 宗泰 (東工大物創)	ビスマス層状構造誘電体の結晶構造異方性を利用した誘電 特性の制御 (東工大物創 ¹ , JST, さきかけ ² , 東理大電気電子情報 ³ : 高橋 健治 ¹ , 渡辺 隆之 ¹ , 竹中 正 ² , 舟窪 浩 ^{1,2})	本間 剛 (東大生研ナノエレクト ロニクス連携センター, 三菱電機)	GaAs(001)基板上InAs wetting layer MBE成長その場合高 温STM観察 (東大生研ナノエレクトロニクス連携センター： 塚本 史郎, 荒川 泰彦)
中田 智成 (バイオニア総研)	アクティブ駆動型HEEDの開発と撮像カメラへの応用 (バイオニア総研 ¹ , NHK技研 ² , 農工大工 ³ :田中 亮太 ¹ , 渡村 一到 ¹ , 根岸 伸安 ¹ , 奥田 義行 ¹ , 佐藤 英夫 ¹ , 酒田 温 ¹ , 吉川 高正 ¹ , 小笠原 清秀 ¹ , 難波 正和 ² , 岡崎 三郎 ² , 谷岡 健吉 ² , 江上 典史 ² , 越田 信義 ³)	橋本 玲 (東芝研究開発センター, 東大生研ナノエレクト ロニクス連携研究センター)	MOCVD法によるGaInAs埋め込みInAs量子ドットの 結晶成長とレーザ試作による評価 (東大生研ナノエレクトロニクス連携研究センター ¹ , 東大 生研 ² , 東大先端科学技術研究センター ³ , 東芝研開セ ⁴ : 藤部 光弘 ^{1,4} , 江崎 瑞仙 ^{1,4} , 波多腰 玄一 ^{1,4} , 西岡 政雄 ^{1,2} , 荒川 泰彦 ^{1,3})
田中 博樹 (九大院システム情報)	レーザー生成プラズマから発生するSn原子のレーザー誘 起蛍光法による可視化計測 (九大院システム情報, 九大医*:松本 篤史, 橋本 祐樹, 高橋 昭彦*, 岡田 龍雄)	岡野 貴之 (東大)	磁化率の温度依存性を利用した反磁性流体の磁気的対流制御 (東大 ¹ , 物材機構 ² :中村 浩之 ¹ , 廣田 憲之 ²)
栗山 博道 (東大新領域)	デラフォサイト型酸化物Cu(Rh _x Mg _{1-x} Al) ₂ O ₂ の熱電特性 (東大新領域 ¹ , CREST-JST ² :岡本佳比古 ¹ , 野原 実 ^{1,2} , 高木英典 ^{1,2})	山岡 慶祐 (阪大院工)	TEOSを用いて作製したSiOCH膜に含まれる炭化水素基 の熱的安定性 (阪大院工：吉迫 裕司, 加藤 英明, 築山 大輔, 寺井 慶和, 藤原 康文)
三浦 正志 (名大工, CREST-JST)	Sm _{1.04} Ba _{1.96} Cu ₂ O ₇ 薄膜の磁場中Jc特性に及ぼすナノサイ ズ低Tc相の影響 (名大工 ¹ , 京大工 ² , 九大工 ³ , 東大工 ⁴ , 電中研 ⁵ , CREST-JST ⁶ :一野 祐亮 ^{1,6} , 吉田 隆 ^{1,6} , 船木 修平 ^{1,6} , 高井 吉明 ¹ , 松本 要 ^{2,6} , 向田 昌志 ^{3,6} , 堀井 滋 ^{4,6} , 一瀬 中 ^{5,6})	周藤 悠介 (東大工)	強磁性Ge _{1-x} Fe _x 薄膜のエピタキシャル成長と磁気特性 (東大工 ¹ , 科技機構SORST ² , 東大新領域 ³ :田中 雅明 ^{1,2} , 菅原 聡 ³)
辻 博也 (有機エレクトロニクス 研究所, 松下電工)	ラマン分光法を用いた有機EL素子の温度測定 (有機エレクトロニクス研究所 ¹ , 松下電工 ² , 山形大工 ³ , 早大理工 ⁴ :小田 敦 ¹ , 城戸 淳二 ^{1,3} , 栢山 卓郎 ¹ , 古川 行夫 ⁴)	竹延 大志 (東北大金研, CREST)	有機分子を用いたナノチューブFETのキャリア密度制御 (東北大金研 ¹ , CREST ² , 理研 ³ , PRESTO ⁴ , 東工大 ⁵ : 菅原 孝直 ^{1,2} , 若佐 義宏 ^{1,2} , 塚越 一仁 ^{3,4} , 青柳 克信 ^{3,5})
小山田 崇人 (千歳科技大)	局所ドーピング法による有機発光型トランジスタのEL 発光及びキャリア再結合サイトの解析 (千歳科技大 物質光科学科 ¹ , ローム ² , 三菱化学 科学 技術研究センター ³ , 京都大学 IIC ⁴ :奥 良彰 ² , 下地 規之 ² , 秋山 誠治 ³ , 松重 和美 ⁴ , 雀部 博之 ¹ , 安達 千波矢 ¹)	前田 雅俊 (筑波大, CREST/JST)	電流モニタによるカーボンナノチューブの成長本数制御 (産総研 ¹ , 筑波大 ² , 阪大 ³ , CREST/JST ⁴ :上村 崇史 ^{3,4} , 玄 燦慶 ¹ , 松本 和彦 ^{1,3,4})

講演奨励賞受賞記念講演が関連分科で開催されます。(p.5参照)

■第 19 回応用物理学会 講演奨励賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	中分類分科名, 講演タイトルならびに講演者名
3/22 (水)	9:30 ~ 9:45	7号館3 F (733-X)	3.7 生体・医用光学 スーパーコンティニューム光を用いた in-vivo マルチ非線形光学イメージング 東大院・理 ¹ 加納英明, 浜口宏夫
	12:15 ~ 12:30	6号館2 F (621-ZG)	6.2 カーボン系薄膜 高濃度ロンドープ CVD ダイヤモンド超伝導体における Jc 評価 (2) 早大理工 ¹ , 物材機構 ² 手塚真一郎 ¹ , 石綿 整 ¹ , 竹之内智大 ¹ , 高野義彦 ² , 長尾雅則 ² , 坂口 勲 ² , 立木 実 ² , 羽多野 毅 ² , 川原田 洋 ¹
	13:30 ~ 13:45	7号館1 F (713-N)	10.1 作製技術 摩擦転写法による高分子青色偏光 LED の作製 神戸大 ¹ , 産総研光技術 ² , 九工大 ³ 三崎雅裕 ^{1,2} , 永松秀一 ^{2,3} , 近松真之 ² , 吉田郵司 ² , 阿澄玲子 ² , 谷垣直孝 ² , 八瀬清志 ² , 上田裕清 ¹
	13:30 ~ 13:45	7号館2 F (721-Q)	13.7 エピタキシーの基礎 GaAs(001) 基板上 InAs quantum dot MBE 成長その場高温 STM 観察 東大生研 NCRG ¹ , 三菱電機 ² 本間 剛 ^{1,2} , 塚本史郎 ¹ , 荒川泰彦 ¹
	13:45 ~ 14:00	6号館B1 F (6B2-ZF)	13.4 III-V 窒化物結晶 ECR-MBE 法を用いた窒化 R 面サファイア基板上 A 面 InN 成長とその成長機構 立命館大学理工学部 ¹ , COE 推進機構 ² 熊谷裕也 ¹ , 露口招弘 ¹ , 渡辺幸夫 ¹ , 黒内正仁 ¹ , 寺木邦子 ¹ , 荒木 努 ¹ , 直井弘之 ² , 名西徳之 ^{1,2}
	13:30 ~ 13:45	3号館2 F (321-ZP)	16.1 合同セッション D 「プラズマ CVD の基礎と応用」 TEOS を用いて作製した SiOCH 膜に含まれる炭化水素基の熱的挙動 阪大院工 ¹ 山岡慶祐, 吉迫裕司, 加藤英明, 築山大輔, 中村大輔, 寺井慶和, 藤原康文
3/23 (木)	11:45 ~ 12:00	3号館1 F (312-ZN)	5.1 半導体レーザー・発光素子 金属ナノ開口アレイ面発光レーザーの偏光モード制御と近接場光生成 東工大 精研 ¹ 橋爪滋郎, 小山三三夫
	13:30 ~ 13:45	7号館4 F (743-ZC)	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源 長尺マイクロ波プラズマのシート化とバルス化 名工大 ¹ 野尻康弘, 山口雄矢, 石島達夫, 菅井秀郎
3/24 (金)	9:30 ~ 9:45	7号館3 F (734-Y)	5.4 光制御 光クロックトランジスタレイを用いた 40-Gb/s 光シリアル—電気パラレル双方向変換器 NIT フォトニクス研究所 ¹ 浦田涼平, 高橋 亮, 末光哲也, 中原達志, 高畑清人, 鈴木博之
	12:00 ~ 12:15	3号館1 F (311-ZM)	17.1 合同セッション E 「スピントロニクス・ナノマグネティクス」 エピタキシャル強磁性半導体 Ge ₂ Fe, 薄膜の結晶性および磁性 東工大 ¹ , 科技機構 SORST ² , 東大新領域 ³ 周藤悠介 ¹ , 田中雅明 ^{1,2} , 菅原 聡 ³
	14:00 ~ 14:15	8号館1 F (815-B)	12.2 超薄膜・量子ナノ構造 通信波長帯超高密度量子ドットのフォトンエコー法による位相緩和測定 情報機構 ¹ , 上智大理工 ² 早瀬 (伊藤) 潤子 ¹ , 赤羽浩一 ¹ , 山本直克 ¹ , 鯨岡真美子 ^{1,2} , 江馬一弘 ² , 佐々木雅英 ¹
	16:45 ~ 17:00	8号館2 F (822-E)	7.1 X線技術 レーザー生成スズプラズマのデブリ挙動可視化計測 九大院システム ¹ , 九大医 ² 田中博樹 ¹ , 橋本祐樹 ¹ , 松本篤史 ¹ , 高橋昭彦 ² , 岡田龍雄 ¹
	13:30 ~ 13:45	7号館2 F (723-S)	6.1 強誘電体薄膜 室温以下でのビスマス層状構造誘電体薄膜の誘電特性 東工大総理工 ¹ , 物材機構 ² , Res. Center Juelich ³ , 東理大理工 ⁴ , JST, さきがけ ⁵ 鈴木宗泰 ¹ , 長田 実 ² , 渡辺隆之 ³ , 竹中 正 ⁴ , 舟窪 浩 ^{1,5}
	13:30 ~ 13:45	7号館3 F (732-W)	11.5 Si プロセス技術 極微細 Si 細線中における不純物原子の拡散評価 早大理工 ¹ , 早大材研 ² 清家 綾 ¹ , 佐野一拓 ¹ , 大泊 巖 ^{1,2}
	13:00 ~ 13:15	3号館1 F (312-ZN)	18.1 合同セッション F 「カーボンナノチューブの基礎と応用」 電流モータによるカーボンナノチューブの成長本数制御 産総研 ¹ , 筑波大 ² , 大阪大 ³ , CREST/JST ⁴ 前田雅俊 ^{2,4} , 上村崇史 ^{3,4} , 松本和彦 ^{1,3,4}
3/25 (土)	11:30 ~ 11:45	8号館2 F (822-E)	4.4 超高速・高強度レーザー 高強度ラマンソリトンと高非線形ファイバを用いた超広帯域フラットスペクトル光の生成 II 名大院工 ¹ 高柳 順, 西澤典彦
	14:00 ~ 14:15	8号館1 F (815-B)	12.2 超薄膜・量子ナノ構造 GaAs 基板上の光通信波長帯デバイスを目指したアンチモン系量子ドットの開発 情報機構 ¹ , 同志社大 ² 山本直克 ¹ , 赤羽浩一 ¹ , 牛頭信一郎 ¹ , 上田章雄 ¹ , 大谷直毅 ² , 土屋昌弘 ¹
	16:00 ~ 16:15	8号館2 F (823-F)	7.7 微小電子源 アクティブ駆動型 HEED の開発と撮像カメラへの応用 (2) バイオエプ ¹ , NHK 技研 ² , 農工大工 ³ 中田智成 ¹ , 松葉陽平 ¹ , 田中亮太 ¹ , 酒村一利 ¹ , 根岸伸安 ¹ , 奥田義行 ¹ , 佐藤英夫 ¹ , 渡辺 温 ¹ , 吉川高正 ¹ , 小笠原清秀 ¹ , 難波正和 ² , 岡崎三郎 ² , 谷岡健吉 ² , 江上典文 ² , 越田信義
	13:00 ~ 13:15	8号館3 F (833-G)	8.5 熱電変換 デラフォサイト型酸化物 CuRh _{1-x} Mg _x O ₂ の高温熱電特性 東大院新領域 ¹ , CREST-JST ² , 東大院理 ³ 栗山博道 ¹ , 野原 実 ^{1,2} , 笹川崇男 ^{1,2} , 田久保 耕 ³ , 溝川貴司 ¹ , 淡松健仁 ¹ , 木村 薫 ¹ , 高木英典 ^{1,2}
	13:00 ~ 13:15	8号館3 F (833-I)	10.7 生物・医用工学・バイオチップ 感光性シートを用いたマイクロ流体デバイスの基礎特性評価 神奈川産総研 ¹ , 日立化成工業 ² , 慶応大理工 ³ , JST(CREST) ⁴ 伊藤 健 ¹ , 川口 卓 ² , 三好裕子 ² , 丸山健一 ³ , 本田亜希 ⁴ , 大屋誠志郎 ¹ , 鈴木孝治 ^{3,4}
	13:00 ~ 13:15	8号館3 F (833-K)	9.3 薄膜, 厚膜, チープ作製プロセスおよび結晶成長 ナノイテズ低 T _m 相導入 LTG-Sm _{1-x} Ba _x CuO ₂ 薄膜のピンニング特性 名工大 ¹ , 京工大 ² , 九工大 ³ , 東工大 ⁴ , 電中研 ⁵ , CREST-JST ⁶ 三浦正志 ^{1,6} , 吉田 隆 ^{1,6} , 一野祐亮 ^{1,6} , 尾崎壽紀 ^{1,6} , 高井吉明 ¹ , 松本 要 ^{2,6} , 向田昌志 ^{3,6} , 堀井 滋 ^{4,6} , 一瀬 中 ^{5,6}
	13:30 ~ 13:45	7号館1 F (711-L)	4.7 レーザー・プロセッシング 紫外レーザー照射によるガラス表面への光触媒能を有する TiO ₂ 網目構造の形成 産総研 光技術研究部門 ¹ , 日本板硝子 ² 奈良崎愛子 ¹ , 川口喜三 ¹ , 新納弘之 ¹ , 小路谷将範 ² , 小川広隆 ² , 常友啓司 ²
	13:30 ~ 13:45	7号館1 F (714-P)	4.3 レーザー装置・材料 位相共役鏡を用いた高出力高品位ピコ秒レーザーシステム 千葉大工 ¹ 尾島靖國, 縄田耕二, 後藤正人, 尾松孝茂
	13:30 ~ 13:45	7号館2 F (721-Q)	10.4 光機能材料・デバイス 円偏光照射によるアキラナアゾダイマー液晶のキラリティー制御 東大院理工 ¹ 星野雄亮, 泉 達矢, 渡辺順次, 竹添秀男, Suk-Won Choi
	13:30 ~ 13:45	7号館2 F (723-S)	6.1 強誘電体薄膜 ZnO/YMnO ₂ ヘテロ構造を用いた強誘電体ゲート薄膜トランジスタの電気特性 阪府大工 ¹ 新井涼太, 重光学道, 益子慶一郎, 吉村 武, 芦田 淳, 藤村紀文
	13:00 ~ 13:15	7号館2 F (724-T)	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶 MOCVD 法による GaInNAs 埋め込み InAs 量子ドットの結晶成長とレーザー試作 NCRG ¹ , IIS ² , RCAST ³ , Toshiba RDC ⁴ 橋本 玲 ^{1,4} , 橋部光弘 ^{1,4} , 江崎瑞仙 ^{1,4} , 波多腰玄一 ^{1,4} , 西岡政雄 ^{1,2} , 荒川泰彦 ^{1,2,3}
	13:30 ~ 13:45	7号館3 F (733-X)	11.6 Si デバイス/集積化技術 面方位 (110) 極薄 SOI ゲート nMOS におけるポリュームインバージョンによる移動度向上 東大生研 ¹ 筒井 元, 齋藤真澄, 更屋拓哉, 南盛俊治, 平本俊郎
	13:45 ~ 14:00	7号館3 F (733-X)	11.6 Si デバイス/集積化技術 横方向歪み緩和を利用して作製した高駆動力一軸歪み SGOI pMOSFETs MIRAI-ASET ¹ , MIRAI-AIST ² , 東芝セラミックス ³ , 東大新領域 ⁴ 入沢寿史 ¹ , 沼田敏典 ¹ , 手塚 勉 ¹ , 白田宏治 ¹ , 平下紀夫 ¹ , 杉山直治 ¹ , 豊田英二 ³ , 高木信一 ^{2,4}
	13:00 ~ 13:15	7号館4 F (744-ZD)	3.4 計測光学 分光偏光変調器による偏光計測 東京農工大 ¹ 若山俊隆, 大谷幸利, 梅田倫弘
13:00 ~ 13:15	6号館2 F (621-ZG)	10.9 特定テーマ A 有機トランジスター 局所ドーピング法による有機発光型トランジスターの EL 発光機構の解明 千歳科学技術大学・物質光科学科 ¹ , ローム ² , 三菱化学 科技研セ ³ , 京都大学 IIC ⁴ , 九州大学・未来化学創造センター ⁵ 小山田崇人 ¹ , 奥 良彰 ² , 下地規之 ² , 秋山誠治 ³ , 松重和美 ¹ , 雀部博之 ¹ , 安達千波矢 ^{1,5}	
13:00 ~ 13:15	3号館1 F (312-ZN)	18.1 合同セッション F 「カーボンナノチューブの基礎と応用」有機分子を用いたナノチューブ FET の特性制御 東北大金研 ¹ , CREST ² , 理研 ³ , PRESTO ⁴ , 東工大 ⁵ 竹延大志 ¹ , 菅原孝宜 ^{1,2} , 岩佐義宏 ^{1,2} , 塚越一仁 ^{3,4} , 青柳克信 ^{3,5}	
3/26 (日)	9:00 ~ 9:15	1号館2 F (123-ZR)	12.5 半導体光物性・光デバイス 新成長法「中心凝固キャスト成長法」による太陽電池用 Si バルク結晶の成長とその有用性の実証 東北大金研 ¹ 野瀬嘉太郎, 高橋 勲, 藤原航三, 宇佐美徳隆, 中嶋一雄
	14:30 ~ 14:45	8号館1 F (814-A)	15.7 磁場応用 定常磁場による反磁性流体の対流制御 東大新領 ¹ , 物材機構 ² 岡野貴之 ¹ , 中村浩之 ¹ , 廣田憲之 ²
	13:00 ~ 13:15	6号館3 F (633-ZK)	10.8 有機 EL ラマン分光法を用いた有機 EL 素子の温度測定 有機エレクトロニクス研究所 ¹ , 松下電工 ² , 山形大工 ³ , 早大理工 ⁴ 辻 博也 ^{1,2} , 小田 敦 ¹ , 城戸淳二 ^{1,2} , 相山卓郎 ⁴ , 古川行夫 ⁴